



Toshiba lance des MOSFET de puissance 100V canal-N pour applications industrielles

Nouveaux dispositifs U-MOS IX-H offrant la plus faible résistance à l'état passant dans leur catégorie.

Düsseldorf, Allemagne, 07 février 2018 – Toshiba Electronics Europe a commencé à commercialiser deux nouveaux dispositifs 100V dans sa gamme de MOSFET de puissance U-MOS IX-H canal-N basse-tension. Ces nouveaux dispositifs sont parfaitement adaptés aux alimentations électriques présentes dans les équipements industriels, ainsi qu'aux applications de commande moteur.

Fabriqués grâce au dernier procédé "trench" basse-tension U-MOS IX-H de Toshiba, qui optimise la structure des éléments, les TPH3R70APL et TPN1200APL offrent les plus faibles résistances à l'état passant du marché, avec respectivement 3.7 m Ω et 11.5 m Ω . Ces dispositifs présentent une faible charge en sortie (Q_{oss} : 74 / 24 nC) et une faible charge de commutation de porte (Q_{sw} : 21 / 7,5 nC), et on peut les piloter avec un niveau logique 4,5V.

Par rapport aux dispositifs actuels produits avec le procédé U-MOS VIII-H, ces nouveaux dispositifs présentent de meilleures valeurs de mérite que les autres MOSFET pour applications de commutation, notamment $R_{DS(ON)} \cdot Q_{oss}$, et $R_{DS(ON)} \cdot Q_{sw}$.

Le TPH3R70APL se présente en boîtier SOP Advance de 5 x 6 mm et peut supporter des courants de drain (I_D) jusqu'à 90A, tandis que le TPN1200APL se présente en boîtier TSON Advance de 3 x 3 mm et supporte des niveaux I_D jusqu'à 40A.

Toshiba Electronics Europe va continuer d'étendre son offre MOSFET, en cohérence avec les tendances du marché, afin de continuer d'améliorer le rendement des alimentations électriques.

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

Fondé en 1973 à Neuss en Allemagne, TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Akira Morinaga.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Février 2018

Réf : 7115/A